DC メタンプラズマ下で成長する炭素粒子の形態形成

長井 達三, 生地 文也 九州共立大学総合研究所

Morphology Formation of Carbon Particles under a DC Methane Plasma

Tatsuzo NAGAI and Fumiya SHOJI

Abstract

Morphology Formation for carbon particles of nanometer-micron sizes growing in a gas phase under a DC methane plasma is investigated theoretically using the following model. Morphology of the particles is determined by competition between the collision time of the particles in the gas phase and the sintering time of the particle in the condensed phase. It is spherical if the collision time is longer than the sintering time, while non-spherical or agglomerate if shorter. The collision time and the sintering time strongly depend on particle gas temperature and particle temperature itself, respectively. A phase diagram for particle morphology is obtained from the temperature dependence of the two times. Comparing the phase diagram with our experimental result, it is concluded that the particle temperature is over 1520K in the experiment with substrate temperature 1100 K.

Keywords: Carbon particle, Methane plasma, Collision time, Sintering time

1. 序論

1.1 研究の目的

新しいナノスケールの物質を気相成長法で合成しようとするとき、解決すべき一つの課題はその物質の相状態と形態の制御法を見出すことである。本研究の目的は、メタンプラズマを使った CVD 法により創生されたミクロンサイズの球状炭素粒子 1-3の相状態と形態形成の機構を明らかにして、その制御法の基礎をつくることである。

1.2 メタンプラズマ下での炭素粒子の合成

先に我々は低圧 DCメタンプラズマ下で成長し たミクロンサイズの球状炭素粒子を観測した¹⁾。 これらは鉛直方向に立てた円柱状プラズマ直下 の熱 Si(100) 基板上に作製された炭素薄膜の SEM 観察によって発見された。その一例を Fig. 1 に示す。

この図には、多くのミクロンサイズの粒子が見 える。高分解能SEM、EDS及び高分解能TEMによ る観察から、これらの粒子は約10nmのグラファ イトオニオンからなることが確認された²⁾。 グ ラファイトオニオンは殻構造をもち、高い機械的 安定性(オニオン様構造)をもつことが報告され ている⁵⁾。

我々はこの球状炭素粒子の成長について、次の 様なモデルを提出した³。すなわち、負に帯電し た球状炭素粒子はプラズマと基板間のシース領



Fig. 1 Si(100)基板表面の SEM 顕微鏡写真 メタン成分比 14% (容積比 CH₄/(Ar+CH₄))。基板温 度を 1100K に保ち、プラズマ照射を 2 時間行った。 バーは 5 µ m、プラズマ励起圧は 4×10² [Pa]²。

域において、上向きに電気力を下向きに重力を受けるが、この2力が丁度釣り合うために、安定してグラファイトオニオンを捕集しながら成長する、という理論モデルである³⁾。このモデルによると、球状炭素粒子の直径は、時間の1乗で増大し、捕集するグラファイトオニオンの減少と共に飽和の傾向を示す。

上述のモデルにおいて、我々はグラファイトオ ニオンとミクロンサイズの炭素粒子形成の出発 点となる初期炭素微粒子(precursor)の存在を 前提にした。これについては、Watanabe 等によっ て、RF シラン(SiH4) プラズマ中の Si 微粒子 成長の実験的研究がなされている 4。この研究に よると、Si 微粒子は プラズマシース領域でその 核ができ、初期成長期に直径 10nm 程度の初期微 粒子が形成され、急速成長期を経て直径約 100nm まで成長する。我々の炭素粒子の場合も、直径 100nm 近傍までは、Si 微粒子と同様に初期微粒 子形成がなされるものと仮定した。

更に、Watanabe 等は Si 微粒子への電子付着 を定量的に明らかにした。それは微粒子成長と共 に急速に進み、粒子密度とイオン密度比が 0.01 の場合、直径約 100nm で微粒子 1 個当たりの電 子付着数は 100 個程度に達し、その後はほぼ一定 となる。

本研究の直接的動機は、我々の実験で得られた SEM 写真が示す炭素粒子の多様な形態にある。

Fig.1にその一端を見ることができる。高い真球 度の球状粒子、焼結進行中らしき粒子、数珠状に つながった球状粒子、ある種の規則性で配置され た球状粒子、・・・、などが見られる。このよう な炭素粒子或いは炭素粒子系の形態形成を明ら かにしたいというのがこの研究の出発点である。

1.3 ナノ粒子の焼結

気相成長におけるナノ粒子の形態形成は、初期 微粒子が衝突して、合体し多様な形態に成長する 過程(以下、焼結過程と呼ぶ)として捉えられる。 衝突過程と焼結過程の相対的割合が最終的な形 態を決めるものと考えられる。

Friedlander とWuは2粒子の焼結を、非球状 粒子が原子の固体中拡散によって球状に近付い て行く過程、として記述し焼結時間を導出した⁶。 そこでは、合体粒子の表面張力が形態形成の駆動 力であると仮定された。

Zachariah と Carrier は Si ナノ粒子の焼結を 分子動力学シミュレーション(Molecular dynamics simulation) によって研究した。そこでは、シ ミュレーションの結果が、液滴に対する粘性流機 構モデル、及び固体に対する固体拡散機構モデル と比較された 7.8)。

Sander 等はナノ粒子の焼結を確率論的粒子モ デル(Stochastic particle model)を使って研究した。 そこでは、このモデルにより、SiO₂ について、 各種の分布に加えて TEM スタイル像も計算され、 その結果が実験結果と比較された ⁹。

2. メタンプラズマ下における炭素粒子の形態形成

前節で紹介した、プラズマ下での粒子成長に関 する実験及び理論 1:4) を基礎にして、DC メタン プラズマのシース領域における炭素粒子の形態 形成のモデルを考える。気相状態にある、正負の 荷電をもつ直径約 10nm(*d*≈10nm)のグラファ イトオニオンが結合して直径数 10nm~約 100nm の炭素粒子が形成され、それらが接触衝突によっ て、より大きな粒子を形成していくものと考える。 炭素粒子の周囲に多数存在する電子は、急速な付 着によって粒子を負に帯電させる。直径にある閾 値 d₀ (d ≈ 10nm)が存在して、直径 d が d₀ より 大きくなると、中性粒子と負帯電粒子が増え始め、 それ等が主要な粒子になるものと考えられる 4)。 そうすると、直径が do より大きくなった粒子の それ以降の成長過程は粒子間衝突(中性粒子間及 び中性粒子と負帯電粒子間)の頻度によって次の 様に分類することができる。 Fig. 2 に模式図を 示す(文献9のFig.1を参考にした)。

(a) 無衝突の場合:

直径数 10nm~約 100nm の炭素粒子の粒子密 度が希薄で粒子同士の衝突が無視できる場合は、 一個の粒子は単独で、中性か正のグラファイトオ ニオンを捕集しながら成長する。前論文で我々は、 この場合における粒子半径の時間依存性を与え る式を導出した。

(b) 弱衝突の場合:

粒子密度が増加して粒子同士の衝突が無視で きなくなる場合は、衝突後の粒子同士の焼結によ り球状粒子が生成される。

(c) 強衝突の場合:

粒子密度が更に増加して衝突が頻繁に起きる 場合は、焼結が完了する前に新たな衝突が起こり 非球状粒子が生成される。

Fig. 2 に示すように、粒子の成長段階は、(0) プロローグ、(1)衝突期、(2)焼結期、(3)安定成長 期、に分けることが出来る。

(0) プロローグ Prologue

プラズマシース領域(プラズマ端近傍、プレシ ース及びシースを含む)において、メタンから解 離した炭素原子から、核形成を経て直径約10nm のグラファイトオニオンが成長する。グラファイ トオニオンは各種電荷(中性、正、負)をもち、 炭素粒子の基本構成要素になる^{1:3)}。前節で述べ たように、これらの基本構成要素が衝突結合して 初期炭素微粒子(precursor)が成長する。



Fig.2 炭素粒子の成長過程を示す模式図

- (a) 無衝突の場合 (b) 弱衝突の場合 (c) 強衝突の場合
- (1) 衝突期 (2) 焼結期 (3) 安定成長期 (*d* 炭素粒子直径)
 e-attachment 炭素粒子への電子付着

o-capture 炭素粒子のオニオン捕集

(1) 衝突期 Collision stage

この段階の初期では、初期炭素微粒子(precursor) が互いに接触衝突して結合し小粒子をつくる。更 に小粒子同士が接触衝突して結合しより大きな 粒子をつくる。

これらの粒子は成長ともに、主として、中性か 負の荷電を持つようになる。なぜなら、粒子の表 面積は半径の2乗で増大し、電子付着が急速に 進むため、正電荷をもつ粒子は中性に、中性粒子 は負電荷をもつようになるからである。この負帯 電化は、粒子の成長と共に進み、負帯電粒子が増 大するのに対し中性粒子は減少する。

粒子同士の衝突頻度を特徴付ける量は衝突時 間 τ_{col} である。これは、一粒子が他の粒子と衝突 するとき、一つの衝突から次の衝突までの平均時 間として定義される。

(2) 焼結期 Sintering stage

接触衝突して結合した粒子は、結合粒子の 間で焼結過程が進み、互いに融合して表面積 を小さくするように球状になろうとする。こ の焼結過程を特徴付ける量は焼結時間 r_{sin} である。これは二つの球状粒子からなる結合 粒子が一つの大きな球になるまでの平均時 間として定義される。

2つの過程を特徴付ける時間、 $\tau_{col} \geq \tau_{sin}$ 、の長さの違いが粒子の形状を左右する。最終的な粒子の形状は $\tau_{col} >> \tau_{sin}$ なら球状、 $\tau_{col} << \tau_{sin}$ なら非球状か集塊状となる。

(3)安定成長期 Stable growth stage

粒子直径が十分大きくなり、粒子周囲から の急速な電子付着により安定した負電荷を もつ粒子になる。ほとんどの粒子が負電荷を もつので粒子同士の衝突は起こらず、正電荷 をもつグラファイトオニオンを捕集して更 に大きくなる。

粒子の形は、焼結時間 r_{sin} が十分短けれ ば前期(衝突期)までに形成された形を保ち、 十分長ければ焼結過程が進行する。

前論文³⁾ では、Fig. 2(a) 無衝突衝の場合、 すなわち、衝突時間に比べて焼結時間が十分 短い場合について、球状炭素粒子の成長を調 べたことになる。

4. 炭素粒子の衝突時間と焼結時間

衝突期における炭素粒子は中性か負帯電 状態にある。粒子同士の接触衝突は中性粒子 と中性粒子または中性粒子と負帯電粒子間で起 こるので、これは剛体球同士の衝突と見なすこと ができ、粒子同士の衝突時間は次式¹⁰⁾で与えられ る。

$$\tau_{col} = \frac{1}{4\sqrt{2}n_p \pi r_p^2 < v_p >}$$
(4.1)

ここで、 n_p 及び r_p はそれぞれ炭素粒子の密度 及び半径、そして< v_p >は粒子の平均速度であ る。粒子気体の温度をT、粒子の質量を m_p 、ボ ルツマン定数を k_B とすると、粒子の平均速度は < $v_p >= \sqrt{8k_BT/(\pi m_p)}$ と表される。

炭素粒子同士の焼結は、炭素原子の凝縮相にお ける拡散機構により進むものとすると、焼結時間 は次式で与えられる⁶⁾:

$$\tau_{sin} = \frac{3k_B T_p N}{64\pi\sigma D(T_p)} \tag{4.2}$$

ここで、 T_p は炭素粒子の温度、Nは炭素粒子 中の炭素原子数、 σ はグラファイトの表面張力、 $D(T_p)$ は炭素原子の自己拡散係数である。炭素 粒子の内部温度 T_p は粒子気体の温度Tと一般に は異なる。

この炭素原子の自己拡散係数は、炭素原子の活性化エネルギーに相当する温度を T_a とすると、 $D(T_p) = D_0 \exp(-T_a / T_p)$ と表わされる。ここで、 D_0 は炭素原子の自己拡散係数の定数因子である。

5. 炭素粒子の形態に関する相図

球状炭素粒子が成長するためには、焼結時間 $\tau_{sin}(T_p)$ が衝突時間 τ_{col} より短いことが必要で ある。即ち、式(4.1)と式(4.2)を使って、球状炭 素粒子が形成される条件は次の不等式によって 与えられる。

$$\tau_{sin}(T_p) < \tau_{col}(T):$$

$$\frac{T_p}{T_0} \exp\left[-\alpha(1 - \frac{T_0}{T_p})\right] < \beta \sqrt{\frac{T_0}{T}}$$
(4.3)

ただし、 T_0 は基準にとる温度で $T < T_0 < T_a$ の 範囲にあり、これを使って無次元量 α 及び β を、 それぞれ、 $\alpha \equiv T_a / T_0$ 及び $\beta \equiv \tau_{col}(T_0) / \tau_{sin}(T_0)$ と定義する。

一般的な相図

式(4.3)が表す球状粒子領域の全体を見るため に、この式をパラメタに依存しない形に書き換え る。 基準温度 T_0 を T_a にとると $\alpha = 1$, $\beta = \tau_{col}(T_a) / \tau_{sin}(T_a)$ となる。 無次元変数 $x = T_p / T_a$ 及び $y = T / (T_a \beta^2)$ を導入すると、式 (4.3) は次の様になる。

$$y < \frac{1}{x^2} \exp[2(1-1/x)]$$
 (4.4)

Fig. 3 に式(4.4)が表す炭素粒子の形態に関 する相図を示す。灰色領域が球状炭素粒子が成長 する温度領域で、他の領域が非球状及び集塊状粒 子が成長する領域である。 【研究論文】九州共立大学総合研究所紀要 第6号 2013年3月 Journal of Kvushu Kvoritsu University Research Institute No.6 March 2013

y=T/Ta*beta²



Fig. 3 無次元量による炭素粒子の相図 横軸は粒子温度 Tp を活性化エネルギーに相当す る温度 Ta で割った無次元量、縦軸は粒子気体温度 T を Ta で割った無次元量。灰色領域が球状炭素粒子が 成長する領域(式(4.4)参照)。

Fig. 3 において、球状粒子領域はx=1で最大 値 y=1をとり、xが小さい領域では指数関数 $e^{-2/x}$ で減少し、xが大きい領域ではベキ関数 x^{-2} で減少する。従って、高い粒子温度が球状粒 子を生成するのに効果的である、ということがわ かる。

6. 本実験条件下における相図と粒子温度

我々の実験におけるパラメタを式(4.3)に代入 して炭素粒子の相図を求める。更に、その相図と 実験で得られた粒子の形状から粒子温度を評価 する。

先ず式(4.3)を次のように書き換える。

$$\frac{T}{T_0} < \beta^2 \left(\frac{T_0}{T_p}\right)^2 \exp\left[2\alpha (1 - \frac{T_0}{T_p})\right]$$
(4.5)

基準温度は $T_0 = 3000$ [K]とする。これは、我々の実験における粒子温度T(基板温度で近似する)、約1000 [K]より高く、自己拡散係数の活性化エネルギーに対応する温度(いくつかの金属に対する測定値)、数10000 [K]より低い値を採用した。

(6a) 衝突時間 $\tau_{col}(T_0)$ の値

第2節で述べたように、粒子の直径が閾値 $d_0 \approx$ 100[nm]を越える辺りから、粒子の帯電状態が安

定して、系統的な形態形成が始まるものと考えられる。従って、特徴的な衝突時間 $\tau_{col}(T_0)$ として、この閾値 d_0 をもつ粒子気体の衝突時間を求めることにする。半径 $r_p = d_0/2 = 50.0$ [nm]のグラファイトからなる炭素粒子の質量は $m_p = 9.42 \times 10^{-18}$ [kg]であるから、この粒子の平均速度は $\langle v_p \rangle (T_0) = 1.12 \times 10^{-2}$ [m/s]と求まる。この値と実験結果から得た粒子密度 $n_p = 3.0 \times 10^{14}$ [1/m³]を式(4.1)に代入して、衝突時間は次の様に求まる。

$$\tau_{col}(T_0) = 6.71 \, [s]$$
 (4.6)

上述の粒子密度の値はFig. 1 のSEM写真から 求めた。そのとき、この写真の粒子は、厚さ 0.50[mm]のシース領域で成長した粒子がプラズ マの切断により一斉に落下して基板上に分布し たものである、と解釈した。加えて、直径が $d_0 \approx 100$ [nm]からこの写真の大きさ $d \approx 1600$ [nm]まで成長する間に、強衝突はなかったものと 仮定した。この粒子密度の値は、前論文³⁾で使用 したオニオン密度 $n_{o,ter} = 1.0 \times 10^{14}$ [1/m³]と同 じオーダーであり、そしてプラズマ中の電子密度 より2桁小さい。この結果は我々の粒子成長モデ ルにおいて妥当であるということができる。

(6b) 焼結時間 $\tau_{sin}(T_0)$ の値

炭素粒子同士の焼結時間 $\tau_{sin}(T_0)$ は式(4.2)で 与えられる。その式の炭素原子数Nは、粒子質 量 $m_p \varepsilon$ 炭素原子質量で割って $N = 4.73 \times 10^8 c$ 求まる。表面張力 σ と自己拡散係数に含まれる、 $D_0 c T_a$ は、グラファイトについての適当なデー タが無いので、周期表で炭素と同族の、前者につ いては鉛の値 $\sigma = 0.442$ [N/m] を、後者について は固体ゲルマニウムの値 $D_0 = 1.08 \times 10^{-3}$ [m²/s]、 $T_a = 3.69 \times 10^4$ [K]を使うことにする。

そうすると、自己拡散係数は $D(T_0) = 4.87 \times 10^{-9} [m^2/s]$ となり、粒子の焼結時間は次のように求まる。

$$\tau_{sin}(T_0) = 1.36 \times 10^{-4} \,[\text{s}] \tag{4.7}$$

(6c)炭素粒子の相図

式(4.6)と(4.7)及び $T_a = 3.69 \times 10^4$ [K]から、 式(4.5)に含まれる2つの無次元定数が次の様に 求まる。

$$\alpha = 1.23 \times 10, \ \beta = 4.95 \times 10^4 \tag{4.8}$$

これらを式(4.5)に使って、我々の実験における 温度領域で相図を描くとFig. 4 のようになる。 これはFig. 3 の原点近傍の拡大図に相当する。 灰色領域が球状炭素粒子が成長する領域、他の領 域が非球状及び集塊状粒子が成長する領域であ る。斜めの破線は粒子気体温度と粒子本体の温度 が等しくなる直線 $T = T_n$ を表す。

この直線と球状粒子領域の境界との交点は *T* = 0.510*T*₀ = 1530 [K]である。

Fig. 1 に示す我々の実験では基板温度は 1100[K]であった。粒子気体の温度Tが基板温度 に等しいとすると、我々が観測した球状粒子は $T = 0.367T_0$ 線上の灰色領域にあったと考えられ る。すなわち、この粒子は成長段階(Fig. 2 の 焼結段階から安定成長段階)において、1520[K] 以上であったと評価できる。



Fig. 4 本実験条件下での炭素粒子の相図 横軸は粒子温度 Tp、縦軸は粒子気体温度 T、基準温度 は T₀ =3000 [K]。灰色領域:球状粒子、その他の領域:非 球状粒子・集塊。

7. 議論

(1) 粒子温度が1520[K]以上という結果について 我々はDCメタンプラズマ下で成長する炭素粒 子の形態に関する相図から、我々の実験で得られ た球状粒子(直径数μm)は、その成長段階(直 径約100nm)において1520[K]以上の高温であった、 と推測した。

この結果は、我々が得た多くのSEM写真が示す 様々な粒子の形態から見て自然である。すなわち、 SEM写真には、高真球度の球状粒子、焼結進行中 らしき粒子、数珠状につながった球状粒子、・・・、 集塊、などが見られる。このような形態から判断 すると、成長段階では相当の高温であったと考え られる。

Siナノ粒子の焼結について行われた、分子動力 学シミュレーション⁸⁾では、2粒子が衝突して焼 結が始まる初期に粒子温度が上昇した。⁸⁾これは 我々の結果を支持している。

更に、エアロゾル形成の研究において、ナノ粒 子の融点はサイズが減少すれば下がり、粒子は液 体的(liquid-like)になると報告された。¹²⁻¹⁴⁾ この報告も我々の結果と合致している。

(2) グラファイトの表面張力と自己拡散係数

粒子の衝突時間 τ_{col} と焼結時間 τ_{sin} に含まれる 表面張力 σ と自己拡散係数Dの値は、グラファ イトではなく、グラファイトと同族の元素のもの で代用した。

表面張力 σ は鉛の値 σ = 0.442 [N/m](液体鉛 と気体水素との界面(温度623[K]))を採用した。 自己拡散係数に含まれる、 $D_0 \ge T_a$ は固体ゲルマ ニウムの値 $D_0 = 1.08 \times 10^{-3}$ [m²/s]、 $T_a = 3.69 \times 10^4$ [K]を採用した。この T_a に相当する活性化エ ネルギーは3.18[eV]になるが、これは炭素原子同 士の結合エネルギー3.69[eV/bond]より少し小さ い。これらのパラメタは、将来、グラファイトに ついて測定されることを期待したい。

(3) 粒子温度上昇の起源

本研究で得られた高い粒子温度は何に由来す るのか、すなわち、その起源については、これか らの問題として残された。上述のSiナノ粒子の焼 結に関する研究⁸⁾では、粒子温度の上昇は焼結の 進行によるSi原子のダングリングボンドの消滅 によるものと仮定された。本研究における炭素粒 子の温度の上昇も、炭素原子のダングリングボン ドの消滅に起源をもつという考えは一つの有力 な候補である。この考えを進めるには、実験で得 られた球状粒子内部の原子構造を実験的に明ら かにする必要がある。

参考文献

- F. Shoji, Z. Feng, A. Kono, and T. Nagai, Appl. Phys. Lett. 89, 171504(2006).
- 2) Z. Feng, A. Kono, T. Nagai, and F. Shoji, Appl. Phys.

Lett. 90, 221503(2007).

- T. Nagai, Z. Feng, A. Kono, and F. Shoji, Phys. Plasmas 15, 050702(2008).
- 4) Review: Y. Watanabe, J. Phys. D: Appl. Phys. **39**, R329 (2006).
- 5) F. Banhart, T. Füller, Ph. Redlich, and P. M. Ajayan, Chem. Phys. Lett. **269**, 349(1997).
- 6) S. K. Friedlander and M. K. Wu, Phys. Rev. B49, 3622 (1994).
- M. R. Zachariah, M. J. Carrier, and E. Blaisten-Barojas, J. Phys. Chem. **100**, pp. 14856 (1996).
- M. R. Zachariah and M. J. Carrier, J. Aerosol Sci. 30, No. 9, 1139 (1999).
- 9) M. Sander, R. H. West, M. S. Celnik, and M. Kraft, Aerosol Sci. Tech. 43}, 978 (2009).
- M. A. Lieberman and A. J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing* (John Wiley and Sons, New Jergey, 2005).
- Chronological Scientific Tables 2010 ed. by National Astronomical Observatory of Japan (in Japanese, Maruzen Co. Ltd., 2009).
- 12) S. N. Rogak, Aerosol Sci. Tech. 26, 127 (1997).
- 13) S. Tsantilis and S. E. Pratsinis, AIChE 46, 407 (2000).
- 14) S. Tsantilis, H. Briesen, and S. E. Pratsinis, AerosolSci. Tech. 34, 237 (2001).

(原稿受付 2013 年 1 月 21 日)